

産業応用フォーラムのご案内

産業応用フォーラム「次世代パワーデバイスとその応用技術」

【概要】 SiC や GaN デバイスを応用した次世代パワーデバイスの実用化が見えてきました。これらデバイスの実用化により、大幅な電力損失低減が期待されていますが、一方で、スイッチングの高速化に伴う EMI ノイズの増加など新たな課題も指摘され始めています。

本フォーラムでは、SiC および GaN デバイスの開発状況と主な特性のほか、それらを家庭用エアコンなどのアプリケーションに適用するための技術や、適用後の諸特性を解説します。また、SiC-MOSFET および GaN-FET で構成した三相 200V4kW 級インバータの動作を実演しながら、次世代パワーデバイスとその応用技術の具体例や勘所を解説します。

【日時】平成 24 年 9 月 1 1 日(火)

【場所】芝浦工業大学豊洲キャンパス, 1 階テクノプラザ

135-8548 東京都江東区豊洲 3-7-5, http://www.shibaura-it.ac.jp/about/campus_toyosu.html

【プログラム】

司会：齋藤 真（芝浦工業大学）

- (1) 13:00~14:00 次世代デバイス(SiC) 搭載インバータエアコンの開発状況
齋藤 勝彦（三菱電機）
- (2) 14:10~15:10 GaN デバイスの開発事例と特性例（仮題）
町田 修（サンケン電気）
- (3) 15:20~16:20 次世代パワーデバイスインバータの EMI ノイズ特性とその対策
齋藤 真（芝浦工業大学）
- (4) 16:30~17:00 SiC-MOSFET および GaN-FET インバータの動作実演
齋藤 真（芝浦工業大学）

【参加費】テキスト代を含みます。

会員(正員)	会員(准,学生員)	非会員	非会員(学生)
10,000 円(非課税)	5,000 円(非課税)	20,000 円(税込)	10,000 円(税込)

【お申込方法】開催前日までに、下記申込用紙を FAX か E メールアドレスにご送信願います。定員 25 名に達し次第、締め切らせていただきます。

【参加費のお支払い方法】参加費は当日現金にてお支払い願います。領収書は原則として開催当日に発行いたします。領収書について特別なご指示がある場合は申込時にご連絡ください。

【主催】(社)電気学会 産業応用部門 半導体電力変換技術委員会（委員長 佐藤 之彦（千葉大学））

フォーラム申込用紙

お申込・お問合せ先：齋藤 真（芝浦工業大学）Email:i029406@sic.shibaura-it.ac.jp, FAX: 03-5859-8201

御氏名：	御社名：
電気学会会員正員, 准・学生員 非会員, 非会員(学生) (いずれかに○をつけてください)	E-mail： TEL：